

اثر لبه

mamwad@mailaps.org

محمد خرمی

یک خازن با-الکتردها-ی-موازی بررسی میشود؛ که هر یک از الکتردها ی ش یک نیم-صفحه است، و از لبها ی ش یک صفحه میگذرد که بر الکتردها عمود است. برای این خازن، شکل دقیق پتانسیل الکتریکی به دست میآید و اثر لبه بررسی میشود.

0 درآمد

خازن ی را بررسی میکنم که د الکترد دارد و هر یک از الکتردها ی ش یک نیم-صفحه است. این نیم-صفحهها با هم موازی یند. لبها ی خازن (لبها ی نیم-صفحهها) هم با هم موازی یند. به این ترتیب مسئله در راستا ی موازی با لبها تقارن انتقالی دارد. همچنین، صفحه ی شامل لبها بر الکتردها عمود است. مختصات دکرتی ی (x, y, ζ) را چنان میگیرم که الکترد j به شکل $(\mathbb{E}_j \times \mathbb{A}_3)$ است، که

$$\mathbb{E}_j = \{(x, y_j) \mid x \leq 0\}. \quad (1)$$

$$y_j = (-1)^j \ell. \quad (2)$$

z مقادیر 1 یا 2 را میگیرد و \mathbb{A}_3 محور ζ است. به \mathbb{E}_j خط - الکترو z میگوییم. درون خازن $(\mathbb{V} \times \mathbb{A}_3)$ است:

$$\mathbb{V} = \mathbb{R}^2 \setminus (\mathbb{E}_1 \cup \mathbb{E}_2). \quad (3)$$

\mathbb{R}^2 هم آن صفحه $(\zeta = 0)$ است. به خاطر تقارن انتقالی در راستای محور ζ ، مسئله عملی \mathbb{R}^2 - بُعدی است. این متن در ادامه $[1]$ است. (تقریب) هم آن نمادگذاریها z را به کار میبریم: متغیر - مختلط متناظر با (x, y) را با z نشان میدهیم:

$$z = x + iy. \quad (4)$$

کلیسی را با Δ نشان میدهیم. پتانسیل (ϕ) درون خازن همساز است:

$$(\Delta \phi)(z) = 0, \quad z \in \mathbb{V}. \quad (5)$$

همچنین، ϕ بر هر یک از الکتروها ثابت است:

$$\phi(z) = \phi_j, \quad z \in \mathbb{E}_j. \quad (6)$$

و بدون کاستن از کلیت، ϕ_j ها را چنین میگیریم.

$$\phi_j = (-1)^j b. \quad (7)$$

1 نگاهت ساده - کننده

نگاشت \tilde{f} را چنین تعریف میکنم.

$$\tilde{f}(w) = 1 + w + \exp w. \quad (8)$$

w یک متغیر مختلط است. \tilde{f} یک شکل بی-بُعد شده f است:

$$f = \frac{\ell}{\pi} \tilde{f}. \quad (9)$$

$$w = u + iv. \quad (10)$$

که u و v حقیقی یَند. دیده میشود

$$\mathbb{E}_j = f(\mathbb{B}_j). \quad (11)$$

که \mathbb{B}_j یک خط افقی است:

$$\mathbb{B}_j = \{(u, v_j) \mid u\}. \quad (12)$$

$$v_j = (-1)^j \pi. \quad (13)$$

و البته،

$$\mathbb{V} = f(\mathbb{U}). \quad (14)$$

که \mathbb{U} یک نوار افقی است:

$$\mathbb{U} = \{(u, v) \mid u \in \mathbb{R}, v \in (-\pi, \pi)\}. \quad (15)$$

که \mathbb{R} مجموعه ی عددها ی حقیقی است. پتانسیل چنین میشود.

$$\phi = \frac{b}{\pi} v. \quad (16)$$

این ϕ همساز است، چون v همساز است. پس معادله ی (5) برآورده میشود. و رُشن است که ϕ به شکل

(16) شرط - مرزیها ی (6)، همراه با (7)، را هم بر میآورد. مفصل-شده ی (8) چنین است.

$$\tilde{x} = 1 + u + (\exp u) \cos v. \quad (17)$$

$$\tilde{y} = v + (\exp u) \sin v. \quad (18)$$

که \tilde{z} بی-بُعد-شده ی z است:

$$z = \frac{\ell}{\pi} \tilde{z}. \quad (19)$$

از (17) و (18) نتیجه میشود

$$\tilde{x} = 1 + \ln \frac{\tilde{y} - v}{\sin v} + \frac{\tilde{y} - v}{\sin v} \cos v. \quad (20)$$

$$|\tilde{y}| = \cos^{-1}[(\tilde{x} - 1 - u) \exp(-u)] + [\exp(2u) - (\tilde{x} - 1 - u)^2]^{1/2}. \quad (21)$$

رابطه ی (20) یک معادله برای v ، بر حسب (\tilde{x}, \tilde{y}) است. به این ترتیب بستگی ی ϕ به (x, y) به دست میآید.

درون و بیرون خازن دقیق خُش-تعریف نیست: ∇ تقریب همه ی صفحه است. اما برای x ها ی منفی با قدر-مطلق بزرگ، میشود ناحیه ی بین دُ-الکتُرُد $|y|$ کوچکتر از ℓ را درون و ناحیه ی بیرون دُ-الکتُرُد $|y|$ بزرگتر از ℓ را بیرون تعریف کرد. یک راه برای ی دقیق-کردن تعریف درون و بیرون این است: لپها با یک سطح به هم وصل شوند، چنان که اجتماع این سطح و الکتُرُدها مرز دُ مجموعه ی بی-اشتراک فضا شود. به طُر خاص، یک تعریف دقیق (و البته قراردادی) برای درون و بیرون چنین است. ∇_- را درون و ∇_+ را بیرون تعریف میکنم:

$$\nabla_\alpha = f(U_\alpha). \quad (22)$$

که α مقادیرا ی $-$ و 0 و $+$ را میگیرد و

$$U_\alpha = \{(u, v) \mid u \in \mathbb{R}_\alpha, v \in (-\pi, \pi)\}. \quad (23)$$

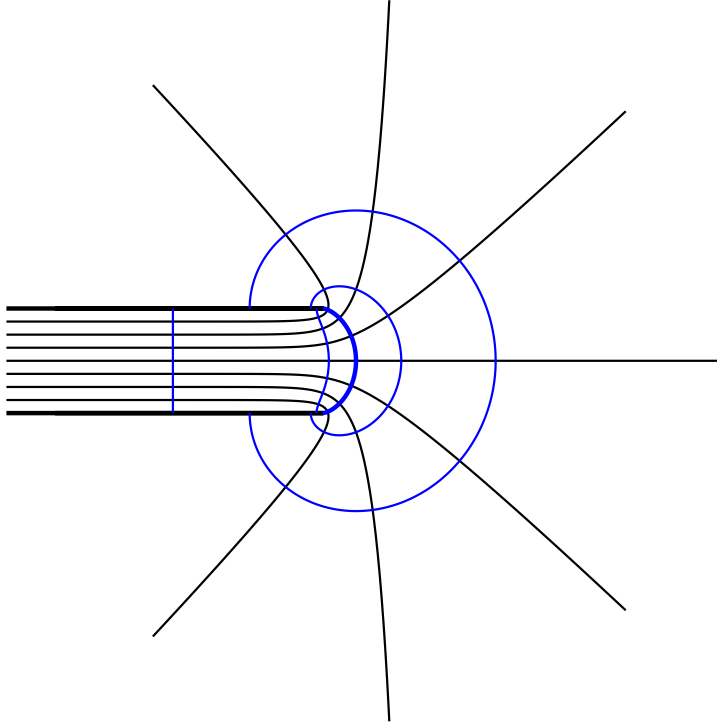
\mathbb{R}_+ \mathbb{R}_- مجموعه ی عددها ی حقیقی ی منفی (مثبت) است، و \mathbb{R}_0 هم ان $\{0\}$ است. ∇_0 ، همراه با تصویر الکتُرُدها بر صفحه ی $(z = 0)$ ، درون-و-بیرون (قراردادی ی) ∇ را از هم جدا میکند. معادله ی پارامتری برای ∇_0 چنین است.

$$\tilde{x}(0, v) = 1 + \cos v. \quad (24)$$

$$\tilde{y}(0, v) = v + \sin v. \quad (25)$$

اینها معادله ی یک چرخه از یک چرخزادند. کلیتر، معادلات-پارامتری ی هر خط-میدان هم ان روابط (17) و (18) با یک u ی ثابت (و البته یک z ثابت)ند، و معادلات-پارامتری ی هر سطح-هم-پتانسیل هم ان روابط (17) و (18) با یک v ی ثابتند.

شکل 1 سطحها ی هم-پتانسیل (سیاه) و خط- میدانها (آبی) را نشان میدهد. خطها ی کلفت درون-و-بیرون (قراردادی ی) ∇ را از هم جدا میکنند.



شکل 1

خطها ی سیاه سطحها ی همپتانسیل ند. خطها ی سیاه کلفت الکترونها یند. سطحها ی هم-پتانسیل برا ی v برابر با $(v = -\pi)$ تا $(v = \pi)$ نشان داده شده اند. جهت افزایش v (در طرف چپ) عمودی رو-به-بالا است. اختلاف مقادارها ی v برا ی دُسطح- همپتانسیل مجاور $(\pi/4)$ است. خطها ی آبی خط- میدانها یند. خط آبی ی کلفت $(u = 0)$ است.

2 چگالی ی بار

چگالی ی سطحی ی بار بر الکتروُد 2 را با σ نشان میدهم:

$$\frac{\sigma}{\varepsilon} = -\hat{n} \cdot \nabla \phi. \quad (26)$$

ε گذردهی ی-الکتریکی ی محیط و \hat{n} بردار -یکه ی عمود-بر-سطح است، و طرف راست (و عبارتها ی بعدی) بر الکتروُد 2 محاسبه میشود. سطحها ی u -ثابت بر الکتروُد عمودند. پس،

$$\hat{n} \cdot \nabla u = 0. \quad (27)$$

به این ترتیب،

$$\frac{\sigma}{\varepsilon} = \left(\frac{\partial s}{\partial v} \right)^{-1} \frac{d\phi}{dv}. \quad (28)$$

که s طول -قوس است:

$$(ds)\hat{n} = \left| \frac{\partial z}{\partial v} \right| (dv). \quad (29)$$

پس،

$$(ds)\hat{n} = \frac{\ell}{\pi} |1 - \exp u| (dv). \quad (30)$$

$$\frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{b}{\ell |1 - \exp u|}. \quad (31)$$

چگالی -بر- u را با σ_u نشان میدهم:

$$\sigma_u = \sigma \left| \frac{\partial x}{\partial u} \right|. \quad (32)$$

دیده میشود

$$\frac{\sigma_u}{\varepsilon} = \frac{b}{\pi}. \quad (33)$$

بخش درون - خازن (بیرون - خازن) هر الکترو با u های منفی (مثبت) متناظر است. اگر اثر لبه نبود، چگالی -ی- بار بر هر الکترو؛ بر بخش درون - خازن یکنواخت و بر بخش بیرون - خازن صفر میشد. این چگالی -ی- بار برای الکترو 2 را با σ_0 نشان میدهم:

$$\frac{\sigma_0}{\varepsilon} = \frac{b}{\ell} \Theta(-u). \quad (34)$$

که Θ تابع هویساید [2] است. انحراف σ از σ_0 را با $(\delta\sigma)$ نشان میدهم:

$$\delta\sigma = \sigma - \sigma_0. \quad (35)$$

دیده میشود

$$\frac{\delta\sigma}{\varepsilon} = \left[\frac{b}{\ell(1 - \exp u)} - \frac{b}{\ell} \right] \Theta(-u) + \frac{b}{\ell(-1 + \exp u)} \Theta(u). \quad (36)$$

که نتیجه میدهد

$$\frac{\delta\sigma}{\varepsilon} = \frac{b}{\ell(-1 + \exp |u|)}. \quad (37)$$

همچنین،

$$\delta\sigma_u = (\delta\sigma) \left| \frac{\partial x}{\partial u} \right|. \quad (38)$$

که نتیجه میدهد

$$\frac{\delta\sigma_u}{\varepsilon} = \frac{b|1 - \exp u|}{\pi(-1 + \exp |u|)}. \quad (39)$$

یا،

$$\frac{\delta\sigma_u}{\varepsilon} = \frac{b}{\pi} \exp[u\Theta(-u)]. \quad (40)$$

بار-بر-طول اضافی را با $(\delta\lambda)$ نشان میدهم. $(\delta\lambda)$ انتگرال $(\delta\sigma)$ است. بار-بر-طول اضافی بر درون الکترو از لبه تا x را با $(\delta\lambda_-)(x)$ ، و بار-بر-طول اضافی بر بیرون الکترو از لبه تا x را با $(\delta\lambda_+)(x)$ نشان میدهم:

$$(\delta\lambda_l)(x) = \iota \int_0^{u_l} (du) \delta\sigma_u. \quad (41)$$

که u_l مقادارها ی $-$ و $+$ را میگیرد، u_- منفی است و u_+ مثبت است، و

$$\tilde{x} = 1 + u_l - \exp u_l. \quad (42)$$

دیده میشود

$$\frac{\delta \lambda_l}{\varepsilon} = \frac{b}{\pi} [(1 - \exp u_l) \Theta(-u_l) + u_l \Theta(u_l)]. \quad (43)$$

از جمله،

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} \frac{\delta \lambda_-}{\varepsilon} = \frac{b}{\pi}. \quad (44)$$

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} \frac{\delta \lambda_+}{\varepsilon} = \infty. \quad (45)$$

بار-بر-طول-، اضافی ی کل، بر سطح درونی ی الکترو محدود ولی بر سطح بیرونی ی الکترو بینهایت است. اما،

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} \frac{\delta \lambda_+}{|x|} = 0. \quad (46)$$

که این یعنی میانگین چگالی-ی-بار اضافی بر سطح بیرونی ی الکترو صفر است. البته از (44) رُشن است که میانگین چگالی-ی-بار اضافی بر سطح درونی ی الکترو هم صفر است.

3 پانوشتها

[1] محمد خرمی؛ «ظرفیت، دُ بعد» (2022/01/20) X1-161

[2] Heaviside